1	73	2 ←	Формат	эона Поз	Обозначение		Наименование		Кол.	Приме— чание
*) РЕУН 468323.001 ПЭЗ ТЭ Перечень элементов *)ЛД АА *) РЕУН 468323.001 ВП ТЭ Ведомость помутных изделий *)ЛД АА *) 2 РЕУН 687253.003 ТЭ Плата печатная 1 *)ЛД АА Прочие изделия Прочие изделия Резонатор АБЗО7-120-32.768КНZ-Т 1 ВО2 Резонатор АБЗО7-120-32.768КНZ-Т 1 ВО1 фирма КОЗ Daishinku, Япония Резонатор АБЗО3.001 ТЭ Резонатор ВСКЗУЮ 1 ВО1 фирма КОЗ Daishinku, Япония Резонатор АБЗО3.001 ТЭ Резонатор АБЗО3.001 ТЭ Резонатор ВСКЗУЮ 1 ВО1 фирма КОЗ Daishinku, Япония Резонатор АБЗО3.001 ТЭ Резонатор ВСКЗУЮ 1 ВО1 фирма КОЗ Daishinku, Япония Резонатор АБЗО3.001 ТЭ Резонатор ВСКЗУЮ 1 ВО1 фирма КОЗ Daishinku, Япония Резонатор ВСКЗУЮ 1 ВО1 Пров. Шавликов подп. МВСЗ Пров. Ш	005	700					<u>Документация</u>	<u>1</u>		
*) РЕУН 468323.001 ПЭЗ ТЭ Перечень элементов *)ЛД АА *) РЕУН 468323.001 ВП ТЭ Ведомость помутных изделий *)ЛД АА *) 2 РЕУН 687253.003 ТЭ Плата печатноя 1 *)ЛД АА Прочие изделия Прочие изделия Резонатор АВS07-120-32.768КНZ-Т 1 ВО2 Резонатор ВУКЗ7К проф ВУКЗ7К проф ВУКЗ7К проф ВУКЗ7К проф Прок Дата Прот Вист Проф Проф Проф Проф Проф Проф Проф Проф	имен. 1613.	i *)		<u>РЕУН.468323.001 СБ 2D</u>		Сборочный чертеж			*)ЛД, А4
#) РЕУН 468323.001 ПЭЗ ТЭ Перечень элементов #)ЛД АН *) РЕУН 468323.001 ВП ТЭ Ведомость покупных изделий #)ЛД АН *) 2 РЕУН 4687253.003 ТЭ Плата печатная 1 *)ЛД АН Прочие изделия Прочие изделия Прочие изделия РЕЗОВ В РЕУН 2-2023 подп. ВПЗ В фальтор ВУКЗИ фирма KDS Daishinku, Япония В РЕЗОВ Подпечат подп. ВПЗ В Прат	<u> 7ep8. np</u> 37H, 94	- - - - - - - -)		PEYH.468323.001		Схема электрическая			*)ЛД, А4
*) РЕУН 468323.001 ВП ТЭ Ведомость покупных изделий *)ПД АА Сборочные единицы Прочие изделия Прочие изделия Прочие изделия Прочие изделия Резонатор АВS07-120-32.768КНZ-1 1 ВО2 Резонатор АВS07-120-32.768КНZ-1 1 ВО2 Резонатор ВХХ216 1 ВО1 ФИН ТООТ ПООТ ДОТО ВВИЗТ ПООТ ПООТ ПООТ ПООТ ПООТ ПООТ ПООТ ПО) Jd	, -					принципиальная			
#) 2 PEVH 687253.003 ТЭ Плата печатная 1 *)ЛД А4 Прочие изделия Прочие изде		- * /)		РЕУН.468323.001 ПЭЗ ТЭ		Перечень элементов			*)ЛД, А4
1 2 PEVH 687253.003 ТЭ Плата печатная 1 *)ЛД АН		*/)		РЕУН.468323.001 ВП ТЭ		Ведомость покупных	изделий		*)ЛД, А4
#) 2 PEVH687253.003 ТЭ Плата печатная 1 *)ЛД.ИА Прочие изделия Прочие изделия Резонатор ABS07-120-32.768КHZ-Т 1 BQ2 Резонатор DSX3216 1 BQ1 фирма KDS Daishinku, Япония прочие изделия Резонатор ABS07-120-32.768КHZ-Т 1 BQ2 Резонатор DSX3216 1 BQ1 фирма KDS Daishinku, Япония Резонатор DSX3216 1 BQ1 фирма KDS Daishinku, Япония Резонатор DSX3216 1 BQ1 фирма KDS Daishinku, Япония Резонатор DSX3216 1 BQ1 Проветной подп. МЖ23 подп. МЖ23 подп. МЖ23 подп. МЖ23 Проветный подп. МЖ23 Плата 1 10 Н контр. Мирошников подп. МЖ23 ГЛ Дата 1 10							<u>Сборочные един</u>	<u>ицы</u>		
Резонатор ABSO7-120-32.768КHZ-Т 1 BQ2 Резонатор ABSO7-120-32.768КHZ-Т 1 BQ2 Резонатор DSX321G 1 BQ1 фирма KDS Daishinku, Япония 2 Все РЕУН-2-2023 подп. 300.23 1 Все РЕУН-1-2023 подп. 20021 Узм/лист N докум Подп. Дото Разраб. Подлесный подп. 20021 Пров. Шавликов подп. 20021 Н контр. Мирошников подп. 20021 Управления		*/)	2	PEYH.687253.003 TЭ		Плата печатная		1	*)ЛД, А4
S							Прочие издели	<u> ІЯ</u>		
Pesonamop DSX3216	n da			5			Резонатор ABS07—120—32.	768KHZ-T	1	BQ2
No of the state	>			7			Резонатор DSX321G		1	BQ1
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Инв		+				фирма KDS Daishinku,	Япония		
2 Bce PEVH.2-2023 nogn. 31.07.23 1 Bce PEVH.1-2023 nogn. 08.06.23 Изм. Лист N докум. Подп. Дата Разраб. Подлесный nogn. 08.06.23 Пров. Шавликов nogn. 08.06.23 Н. контр. Мирошников nogn. 08.06.23 VNDABJEHUЯ 1 10										
2 Все РЕУН.2—2023 подп. 31.07.23 1 Все РЕУН.1—2023 подп. 18.06.23 Изм. Лист N докум. Подп. Дато Разраб. Подлесный подп. 18.06.23 Пров. Шавликов подп. 18.06.23 Н. контр. Мирошников подп. 18.06.23 Управления Управления	Взам.									
2 Все РЕУН.2—2023 nogn. 31.07.23 1 Все РЕУН.1—2023 nogn. 18.06.23 Изм. Лист N докум. Подп. Дата Разраб. Подлесный nogn. 18.06.23 Пров. Шавликов nogn. 18.06.23 Н. контр. Мирошников подп. 18.06.23 VNDABЛЕНИЯ										
Разраб. Подлесный подп. №. 66.23 Лит. Лист Лист Пров. Шавликов подп. №. 66.23 Плата Н. контр. Мирошников подп. №. 66.23 Управления		1/1	1 E	Bce F	PEYH.1—2023 nogn. 08.06.23	F	PEYH. 468323.	.001	ТЭ	
Н. контр. Мирошников подп. 18.16.23 УПРАВЛЕНИЯ Утв. Инвециов подп. 18.16.23	I _ I	F	азр	аб. /	Тодлесный подп. <i>18.06.23</i>			Лит.	<u>Пист</u> 1	Листов 10
Копировал Формат A4		1	I . кол Ут		Мирошников <u>подп.</u> 18.16.23 Шавликов подп. 18.16.23					

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме— чание
			9		Конденсатор GRM21BR60J226ME39L	1	C25
					фирма Murata Manufacturing, Япония		
					J		
					Конденсаторы фирма Үадео, Тайвань		
			12		CC0603JRNP09BN120	4	C8,C9,C18,C19
			14		CC0603KRX7R9BB333	1	C22
					00000011171711022200		
			16		CC0603MRX5R7BB105	18	C7,C26-C40,
							C47,C52
							,
a	П						
gama			18		CC0603ZRY5V9BB104	24	C1, C2, C4, C6,
n. u			, 0		000000211101028101		C11-C17,C23,
Подп.							C24,C41-C46,
тдль	H						C48-C51,C55
N gy							010 001,000
Инв.	H						
	H		20		CC0603KRX7R9BB103	1	<i>C3</i>
инв. N			20		CCOOOSKNAANGDDTOS	/	
	H						
Взам.	H		22		CC0603JRX7R9BB103	2	C57 C51
70	H		ZZ		CCOOOJUNA/NYDDIOJ		C53, C54
ı gama	H						
Подп. и	Н		24		000007//DV7D0DD104	1	050
По	H		24		CC0603KRX7R9BB104	1	C56
1/1	H						
I nogn	${f H}$		\Box	<u> </u>			Лист
Инв.N			#	N 7 7	PEYH. 468323. 001	T.	2
	Изм	11100	cm	N докум. Подп. Дата Копи	ровал		1am A4

		Формат	Зона	Поз	Обоз	начение		Наименование	Кол	Приі чані	
				26				Конденсаторы фирма Yageo, Тайвань СС0805ККХ7R7BB475	1	C10	
				28				CC0805KKX5R9BB106	1	<i>C57</i>	
	-			<i>30</i>				CC1206KKX5R8BB106	1	C5	
								COTZOONNAONODDTOO	1	W	
	_			32				Не устанавливать	2	C20, C2	21
				34				Микросхема К7805—500R3	1	DA1	
				<i>-</i>				фирма Mornsun Power, Китай		Dili	
gama								фирма ST Microelectronics, Швейцария			
Подп. и								фирми от инстолестопней, шосицирия			
N gyba			,	37				Микросхема LM2902D	1	DA8	
Инв.				<i>39</i>				Микросхема TS4962IQT	1	DA3	
м. инв. М	_							Тикросхема 1343021Q1	<i>'</i>	DAJ	
па Взам.				41				Микросхема TLV70233DBVT	1	DA2	
Подп. и дата	-	+						фирма Texas Instruments, США			
	_			43				Микросхема RS3007—5.0AYF3	1	DA7	
Инв. И подл.							P	фирма Runic, Kumaŭ EУН. 468323. 001	<u> </u>		Лист З
	Изм Лист N докум. Подп. Дата Г L У I I. 400020.001								ıam A4		

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме– чание
			<i>45</i>		Не устанавливать	3	DA4,DA5,
					,		DA6
			47		Микросхема CP2102N—A02—GQFN20R	1	DD5
					фирма Silicon Labs, США		
			49		Микросхема MAX232ID	3	DD2-DD4
					фирма Texas Instruments, США		
			<i>51</i>		Микросхемы STM32F446RET6	1	DD1
эта					фирма ST Microelectronics, Швейцария		
n g							
Подп.			<i>53</i>		<u>24LCO4B/SN</u> фирма Microchip Technology, США	1	DD6
дубл.					фирма инстостир тестногоду, ошт		
>			<i>E E</i>			1	FD4
N NHB.			<i>55</i>		Предохранитель MF—SMDF050—2 фирма Bourns, США	1	FP1
инв.							
Взам.			<i>57</i>		Светодиоды АРТ1608EC	3	HL1-HL3
gama					фирма Kingbright, Тайвань		7727 7720
Подп. и с							
По			59		Не устанавливать	2	HL4,HL5
подл.							
Инв. N	Mar	Лис	cm -	N докум. Подп. Дата	EYH. 468323.001	ТЭ	<i>Лист</i> 4
<u>Ш</u>	V131V	וען)III 	N докум. Подп. Дата Копирова			nam A4

	Формат	Зона	Поз	Обознач	ление		Наименование	Кол	Приі чанц	
							Ферритовая бусина			
							фирма Murata, Япония			
			61				BLM18AG102SN1D	6	L1-L6	5
							DEMITO/10/1025INTD		21 20	
							Резисторы фирма Yageo, Тайвань			
			66				RC0603FR-070RL	16	R1-R3	3
							NOODON	70	R48,R54	
									R65,R71	
									R82,R88,	R90,
П									R94,R	98,
gama									<i>R121,R</i>	2122
7										
Nogn.			68				RC0603FR-0722RL	4	R15,R16	5,R91,
rg/b									<i>R92</i>	
>										
лнв.			70				RC0603FR-0762RL	1	R130	
инв. И									,,,,,,	
Взам.										
П			72				RC0603FR-07100RL	3	R21,R128	3, <i>R129</i>
u gama										
Подп.			74				RC0603FR-071KL	5	R19,R20	0,R22,
Н	_								R25,R9	5
Инв.И подл.		\Box	\dashv	<u> </u>	1 1					Лист
NHB.N	M21	Лис	n n	N докум. Подп.	Дата	P	EYH. 468323.001	ТЭ		Jiucm 5
Ш	VISIN	y)IU(<i>/</i> 111	N докум. Подп.	дини	Копирова			ıam A4	

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме— чание
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
			77		RC0603FR-071K5L	<u> </u>	R17,R93,R119
			, ,		TOOGOOTT OF THOE		ittriittoojittio
	_		<i>79</i>		RC0603FR-074K7L		<i>R37,R99,</i>
							<i>R100</i>
			81		RC0603FR-0710KL	12	R6,R11,R14,
							R26,R45,R62,
							<i>R79,R115–R117,</i>
	\vdash						R120,R126
эша			83		RC0603FR-0720KL	4	R111–R113,
n da							R131
Nogn.							
rg/b	╁		85		RC0603FR-0722KL	1	R97
N			00		NOOGOTA OFEENE	,	7107
Инв.							
>	_		87		RC0603FR-0727KL	1	R118
м. инв.							
Взам.	╀		89		RC0603FR-0747KL	1	R96
gama							
7							
Подп.			91		RC0603FR-0751KL	1	<i>R125</i>
дл:	_						
Инв.И подл.					<u> </u> 	$T \gamma$	Лист
NHt	Изл	у Ли	ст	IV докум. Подп. Дата	PEYH. 468323. 001		
				Копирова	Л	Форм	nam A4

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	наименование	Кол	Приме— чание
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
			0.4		D000075D 0750W		5444
			94		RC0603FR-0756KL	1	<i>R114</i>
			96		RC0603FR-07100KL	18	R4,R5,
							R7-R10,R12,
							R13,R101-R109,
							<i>R127</i>
					D000075D 07450//		D.70 D.70
			98		RC0603FR-07150KL	2	<i>R38,R39</i>
			100		RC0603FR-071ML	1	R18
тта					NOOGGIN GYIME	•	1170
u gan							
Nogn. u							
rg/b							
8			102		Не устанавливать	54	R23,R24,R27-R29,
Инв.							R30-R36,
инв. N							R40-R43,R44,
							R46,R47,R49-R53, R55,R57-R61,R63,
Взам.							R64,R66-R70,
gama							R72,R74-R77,
n							R78,R80,R81,
Подп.							R83–R86,R87,
							R89,R110,
nogn			i				R123,R124
Инв.N		L	\pm		PEYH. 468323.001	<i>T</i> \nearrow	Лист
	Изм	Лис	cm	N докум. Подп. Дат	Konupoвал		7 nam A4

	Формат	Зона	Поз	Обознач	<i>нение</i>		Наименование	Кол	Приме— чание
							The second of th		
							Диоды фирма ON Semiconductor, США		
			104				MBR130LSFT1G	1	VD5
	H		106				SMF15AT1G	4	VD1-VD3,
									VD14
			108				SM05T1G	5	VD4,
									VD10-VD13
			110				5 014 454	1	1/0.0
7	H		110				Диод SMAJ15A фирма Diodes Incorporated США	1	VD6
даш							фирма Diodes Incorporated США		
Подп. и дата									
			112				Не устанавливать	3	<i>VD7–VD9</i>
rg/b N	\mathbb{H}								
Инв. ∧			114				Thausuamanu 2N7002V	9	1/71 1/75
	H		114				Транзисторы 2N7002K фирма ON Semiconductor, США	9	<i>VT1 – VT5, VT15 – VT18</i>
инв. Л							querra on commonauctor, cen		
Взам. инв. N									
	Ш		109				Не устанавливать	9	VT6-VT14
Nogn. u gama	Н								
n uba									
110									
лодл									
Инв.И подл.			+			D,	EYH. 468323. 001 T	T-)	Лист
Ž	Изм	Лис	ст	N докум. Подп.	Дата	Γ L Konupoβo			1am A4

	Формат	Зона	Поз	Обозначение		Наименование	Кол	Приме— чание
			444			Вилки фирма Connfly Electronic, Kumaŭ		144 19
			111			<u>DS1066–02MVW6</u>	6	X4-X9
			447					1440
			113			DS1066-04MVW6	1	X10
			115				1	1/4
			115			DS1069-2MVW6X	1	X1
			117			Duana 07074 0010	7	V10 V14
			117			Вилка 87834—0819 фирма Molex, США	3	X12-X14
	_							
			119			Вилка 87834—1211	1	X11
[,	_					фирма Molex, США		
u gama								
Подп.			121			<u>Розетка 1050170001</u> фирма Molex, США	2	X15,X16
N gy6л						фирма тогех, сшл		
Инв. N			123			Не устанавливать	2	X2,X3
>	-					The yellianaonaoanib		712,710
Взам. инв.								
	-							
u gama								
Подп.								
тбол	1							
Инв.И подл.	14			M. source D. C.	- PE	EYH. 468323. 001	ТЭ	Лист 9
Ш	<i>V13N</i>	Ли	cm	N докум. Подп. Дата	Копирова			ıam A4

					Лист ре	егистраці	и изменен	ий		
	140.		мера лист	ов (стран	<i>ıuц)</i> 1	Всего листов	Номер	Входящий номер сопрово-	Поапись	Лата
	Изм.	изменен— ных	заменен— ных	новых	анулиро— ванных	(страниц) в документе	документа	Входящий номер сопрово- дительного документа и дата	riognace	дата
	-									
dama										
Подп. и										
1убл.										
Инв. И дубл.										
18. N										
Взам. инв. N										
Nogn. u gama										
Поді										
, nogл.										
инв. И подл.	Изм	Пист № да	окум. Под	п. Дата	f	PEYH. 4	468323	8.001 7	- Э	Лист 10
	715111	raom n ge	7110 g	т. дата	Копировал	7		Формат	11	

Копировал

Формат А4